

关键指标

通带频率: DC~3GHz

插入损耗: 2.1dB

阻带衰减: 20dB@4.6GHz, 40dB@6GHz

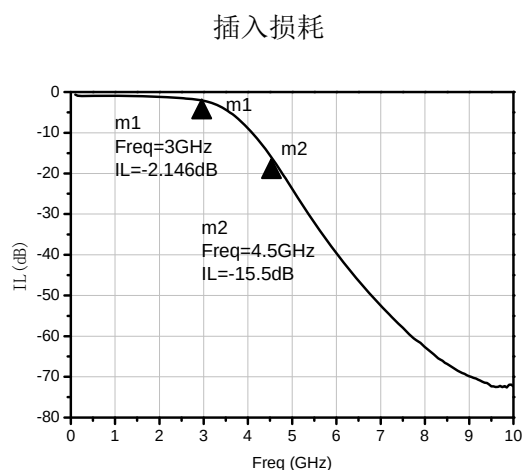
回波损耗: 20dB

芯片尺寸: 1.8mm×0.8mm×0.1mm

电性能 (T_A=25℃)

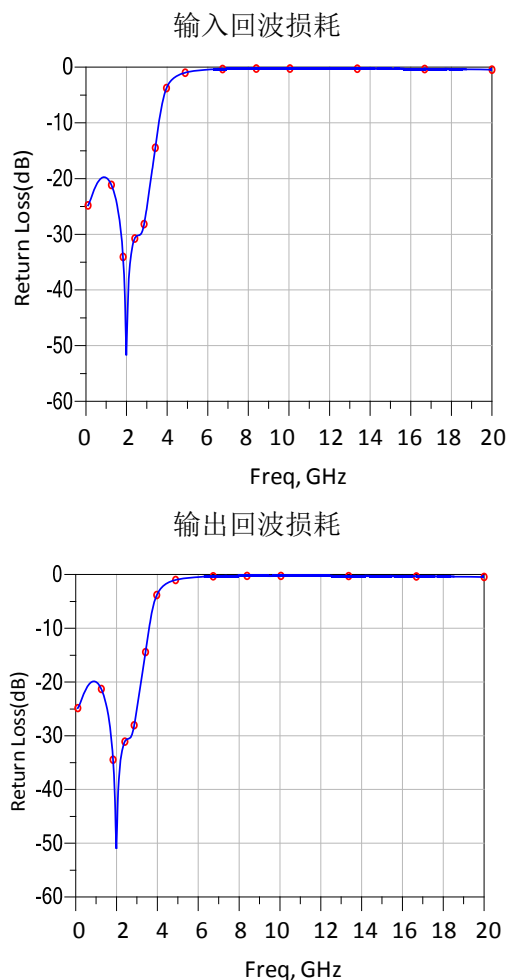
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~3		
输入回波损耗(dB)	-	-	20
输出回波损耗(dB)	-	-	20
插入损耗(dB)	-	2.1	-
阻带衰减 @4.6GHz (dB)	-	20	-
阻带衰减 @6GHz(dB)	-	40	-

典型测试曲线

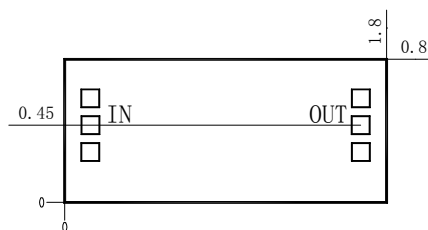


绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃



外形和端口尺寸 (mm)



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。